

$\text{Si} - \text{Cl} - \text{O}$

$\text{Si}_2\text{OSe}_6(\text{m})$ Тб.

2686-IVTKB

Булатова Л.А.

Впределение Тб, 1с.

$\text{Cl}_3\text{SiO SiCl}_3$ (к, м)
(T_m , T_b , ΔvH , S)

~~2686~~
2686-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температуры плавления и кипения, энтальпия
и энтропия испарения гексахлордисилоксана,
5 с.

~~III~~

$\text{Cl}[\text{Si}(\text{Cl})_2\text{O}]_2\text{SiCl}_3$ (к, м)

(T_m , T_b , $\Delta_v H$, S°)

2688-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температуры плавления и кипения, энтальпия
и энтропия испарения октахлортрисилоксана,

3 с.

$[Si(Cl)_2O]_3$ (х, м)
(Тв, Тм)

~~КСД~~
2689-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температуры плавления и кипения гексахлор-
циклотрисилоксана, 1 с.

$[Si(Cl)_2O]_4 (x, z)$
($T_m, T_b, \Delta V H, S$)

~~2689~~
2689^a-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температуры плавления и кипения, энтальпия
и энтропия испарения октахлорциклотетраси-
локсана, 3 с.

$\text{Cl}[\text{Si}(\text{Cl})_2\text{O}]_6\text{SiCl}_3(\text{m})$
(Te)

~~2697~~
2697-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температура кипения гексадекахлоргептасилок-
сана, 2 с.

~~2695-IV-ТХВ~~

$[Cl_3SiSi(Cl)_2OSi(Cl)_2]_2$ (m)
(Tb)

2695-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температура кипения 1,1,2,2-тетрахлор-1,2-
бис/пентахлордисиланиокси/дисилана, 1 с.

~~2696~~

$\text{CC}[\text{Si}(\text{CCl}_2\text{O})_5\text{SiCl}_3]_n$
(76)

2696-IV-TXB

Скороходов И.И.

Температура кипения тетрадекахлоргексасило-
ксана, 2 с.

$\text{ClSiSi}(\text{Cl})_2\text{OSi}(\text{Cl})_2\text{Si}(\text{Cl})_2\text{OSiCl}_3(\text{m})$ ~~2571~~

(76)

2694-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температура кипения 1,1,1,2,2,4,4,5,5,7,7,7-
додекахлор-1,2,4,5,7-пентасила-3,6-диокса-
гептана, 1 с.

$\text{Cl}[\text{Si}(\text{Cl})_2\text{O}]_4\text{SiCl}_3(\text{m})$
(Tb)

~~2693~~
2693-IV-ТКВ

Скороходов И.И.

Температура кипения додекахлорпентасилокса-
на, 1 с.

~~7574~~
 $[Si(Cl)_2O]_5 - (x, y)$
(T_m, T_b)

2692-IV-ТКВ

Скороходов И.И.

Температуры плавления и кипения декахлор-
циклопентасилоксана, 1 с.

~~127~~
 $\text{Cl}[\text{Si}(\text{Cl})_2\text{O}]_3\text{SiCl}_3 (\text{m})$
(ТВ, ΔVН, S)

2691-IV-ТКВ

Скороходов И.И.

Температура кипения, энтальпия и энтропия
испарения декахлортетрасилоксана, 3 с.

$(\text{Cl}_5\text{-Si}_2)_2\text{O}(\text{x}, \text{m})$

$(T_m, T_b, \Delta V H, S)$

~~2690-IV-ТХВ~~
2690-IV-ТХВ

Скороходов И.И.

Температуры плавления и кипения, энтальпия
и энтропия испарения 1,3-бис/трихлорсилил/-
1,1,3,3-тетрахлордисилоксана, 2 с.

$\text{Si}_5\text{O}_2\text{Cl}_{12}$ (m) Tб

2690-IVTKB

Буханова Н.А.

$\text{Si}_4\text{OCl}_{10}$; $\text{Si}_6\text{O}_2\text{Cl}_{14}$; $\text{Si}_8\text{O}_3\text{Cl}_{18}$; $\text{Si}_5\text{O}_2\text{Cl}_{12}$;
Tб, 3c

$Si_6O_2Cl_{14}$ (m) Tb

2690-IVTKB

Буданова А.А.

Si_4OCl_{10} ; $Si_6O_2Cl_{14}$; $Si_8O_3Cl_{18}$;
 $Si_5O_2Cl_{12}$; Tb, 3c.

$\text{Sig } O_3 \text{ Cl}_{18}$ (ne) T6

2690-IVTKB

Буданова Л. А.

$\text{Sig } O \text{ Cl}_{10}$; $\text{Sig } O_2 \text{ Cl}_{14}$; $\text{Sig } O_3 \text{ Cl}_{18}$;

$\text{Sig } O_2 \text{ Cl}_{12}$, T6, 3c.



$Si_4OCl_{10}(m)$ Tb

2690-IVTKB

Динамова Н.А.

Si_4OCl_{10} ; $Si_6O_2Cl_{14}$; $Si_8O_3Cl_{18}$;

$Si_5O_2Cl_{12}$, Tb, 3c.

~~2690-IV-ТКВ~~
 $Si_8O_3Cl_{18}$ (21)
(Tc)

2690-IV-ТКВ

Булатова Л.А.

Температуры кипения Si_4OCl_{10} , $Si_6O_2Cl_{14}$,
 $Si_8O_3Cl_{18}$, $Si_5O_2Cl_{12}$, 3 е.

$Si_6O_2Cl_{14}$ (21)
(76)

~~2024~~

2690-IV-ТЛВ

Булотова Л.А.

Температури кипения Si_4OCl_{10} , $Si_6O_2Cl_{14}$,
 $Si_8O_3Cl_{18}$, $Si_5O_2Cl_{12}$, 3 с.

$\text{Si}_4\text{OCl}_{10}$ (м)
(78)

~~25~~
2690-IV-ТКВ

Булатова Л.А.

Температуры кипения $\text{Si}_4\text{OCl}_{10}$, $\text{Si}_6\text{OCl}_{14}$,
 $\text{Si}_8\text{OCl}_{18}$, $\text{Si}_5\text{OCl}_{12}$, 3 с.

~~2575~~
 $\text{Si}_5\text{O}_2\text{Cl}_{12}$ (2M)
(76)

2690-IV-ТКВ

Бунатова Л.А.

Температуры кипения $\text{Si}_4\text{OCl}_{10}$, $\text{Si}_6\text{O}_2\text{Cl}_{14}$,
 $\text{Si}_8\text{O}_3\text{Cl}_{18}$, $\text{Si}_6\text{O}_2\text{Cl}_{12}$, 3 с.

$\text{Si}_3\text{O}_2\text{Cl}_8$ (м) Тв

2686-IV ТКВ

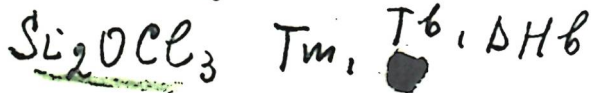
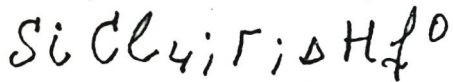
Булатова Л. А.

Определение Тв, тс.

8997-IV

Stock, Somieski, and Nütgen¹⁹¹⁷

1. Ber. 50, 1754 (1917)



u. b.



$\text{Si}_2\text{Cl}_6\text{O}$

Bsp - 9286 - II

1919

Wittgen R.

ΔH_V

Ber. Dtsch. chem. Ges.,
1919, 52, 1724-21

Si_2OCl_6
 $Si_4O_4Cl_8$

Rheinboldt H., Wisfeld W.

Te

Ann. der Chemie, 1935,
517, 197-211

Tu

Si_2OCl_6

$\text{Si}_3\text{O}_2\text{Cl}_8$

BP-5802-IV

1947

Schumb W.C., Stevens A. J.

T₆

J. Am. Chem., 1947, 69, 726

NY 0010

BCP-5804 - IV - 1953

Te

Schinn W. C.

Lepper R. A.

J. Am. Chem. Soc. 75, (1953) 1513

Si₈O₃Cl₁₈

Si₆O₂Cl₁₄

Si₄OCl₁₀

Bp-5805-IV

1954

Schumb W.C. Lefever R.A.

T₆

J. Amer. Chem. Soc., 1954, 76,
148, 2091-2093

5801

-IV

1958

$\text{Si}(\text{ClO}_4)_4$, $\text{Si}(\text{NO}_3)_4$, $\text{Si}(\text{SO}_4)_2$ (Hf)

Hoppe R.

Z. anorg. und allgem. Chem., 1958m
296, N 1-6, 1104-116

Zusammen hänge...

W, M



SiCl_4O_5

20530.9515

X

Si_2OCl_6 ; $\text{C}_2\text{Cl}_3\text{COCl}$ 14/2
(Р, Ткин.) XIV 2075

Некоторые физико-химические свойства гексахлордихлорсилана и трихлорацетилхлорида.

Соколова Т.Д., Голубков Ю.В., Нисельсон Л.А.

В сб. "Теплофиз. свойства веществ и материалов". Вып. 5. М., Изд-^{во} стандартов, 1972. 133-138 **В**

607 620 6 2 4

0631 пик_{реф.} ВИНИТИ

$Si_2O_2Cl_6$

$Si_3O_2Cl_8$

$Si_4O_3Cl_{10}$

$Si_5O_4Cl_{12}$

(Pat, ΔHv)

1973

В.И. Старшенко.

Н.В. Тамуцкий.

"Материалы Всесоюзн.

конференц.", Минск,

май 24-26, 1973г, стр. 188

Si₂OCl₆

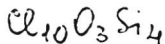
1976

Tret'yakova K. V.

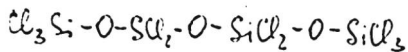
(P)

Izv. Vysk Uchebn Zavod
Tsvetn Metall 1976, (1)
85-9 (Russ)

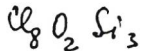
(cu VOCl₃; I)



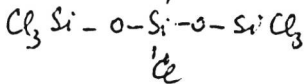
1984



гексахлортетраэтоксисилан



, Cl



Вестн. МПУ. Химия,
1984, 25, N 2, 153-156.

ИК-спектры

ν :

расчет работ



Сел.
Si-Cl-O

III картодека.

[OM. 29942]

1988

SiO_2Cl_6

Si_3OCl_8

Marra G.E., Kreidler E.
et al.,

J. Electrochem. Soc.,

1988, 135, ● N 6, 1571-74
Direct Mass Spectromet-

vic Identification of Sili-
con Oxychloride Compounds.

SiOCl_2

1990

Stewart James J.P.,
Gordon Mark S.

(ΔH_f) Phosphorus, Sulfur
Silicon Relat. Elem.
1990, 47 (1-2), 105-8.
(cf. SiOF_2 ; 1)



1991

Fisher E.R.,
Armentrout P.B.

$\Delta_f H$ J. Phys. Chem. 1991.
95, N 12. C. 4765-4772.

(corr. SiCl_3^+ ; 1)

$(Cl_2SiO)_3$
 $(Cl_2SiO)_4$

1991

24 В9. Изoeлектронная пара SiO/PN. I. Перхлороциклосилоксаны и перхлороциклофосфазены. Колебательные спектры и рентгеноструктурный анализ $(Cl_2SiO)_3$ и $(Cl_2SiO)_4$. Das Isosterepaar SiO/PN. I. Zur isosterie von perchlorcyclosiloxanen und perchlorcyclophosphazenen. Schwingungsspektren und röntgenstrukturanalyse von $(Cl_2SiO)_3$ und $(Cl_2SiO)_4$ / Wannagat Ulrich, Bogedain Gabriele, Schervan Adrian, Marsmann Heinrich C. // Z. Naturforsch. B.— 1991.— 46, № 7.— С. 931—940.— Нем.; рез. англ.

Гексахлороциклотрисилоксан $(Cl_2SiO)_3$ (I) и октахлороциклотетрасилоксан $(Cl_2SiO)_4$ (II) получены р-цией $SiCl_4$ с O_2 при $955^\circ C$. Масс-спектры I и II

структура

Х. 1991, № 24

сопоставлены с масс-спектрами изоэлектронных циклофосфазенов. Подобные колебат. спектры I и II близки к спектрам $(\text{PNCI}_2)_3$, но отличаются от спектров изогнутых молекул $(\text{PNCI}_2)_4$. Выполнен РСТА I и II (структуры комплексов решены по 2134 и 1931 отражению и уточнены до $R=0,054$ и $0,052$, $R_w=0,067$ и $0,086$ соотв.). I и II трикл., a 8,679(3) и 6,1667(6), b 11,146(3) и 8,2486(9), c 6,395(1) и 8,3364(9) Å, α 102,34(2) и 77,311(7), β 107,16(2) и 80,724(6), γ 77,89(3) и 72,667(6)°, ρ (расч.) 2,00 и 1,94 г/см³, $Z=2$ и 1, пр. гр. $P\bar{1}$. Полученные данные свидетельствуют о планарном строении кольцевых систем $(\text{SiO})_n$ ($n=3$ и 4) в силосанах; средние расстояния Si—O составляют 1,619(4) и 1,584(3) Å в I и II соответственно.

1995

F: Cl₈Si₈O₁₂

P: I

7B225. Cl₈Si₈O₁₂. Octachlorosilasesquioxane, Cl₈Si₈O₁₂ / Tornroos K. W., Calzaferri G., Imhof R. // Acta crystallogr. C. - 1995. - 51, N 9. - С. 1732-1735. - Англ.

Бесцветные ромбовидные кристаллы Cl₈Si₈O₁₂ (I) получены фотохимическим хлорированием H₈Si₈O₁₂ (II) и выпариванием из н-гексана под инертным газом. Проведен РСТА (291К, 'лямбда' Мо, 301 отражение, R 0,0459). Параметры гексагональной решетки: а 12,353, с 12,931 А, V 1708,9 А³, Z 3, 'rho' (выч.) 2,041, ф. гр. R $\bar{3}$. Структура I почти изотипна II и (CH₃)₂Si₈O₁₂ (III). Симметрия молекулы I $\bar{3}$ в отличие от II и III (m3m). Среднее Si-O 1,601, 1,618, 1,614 А (I-III). Проведено сопоставление межатомных расстояний и углов I-III.

X. 1996, N 7

Al SiO

(DM-40545)

2000

Milan Remko,

термодин.
устойчив.

Phys. Chem. Chem. Phys.
2000, 2, N 6, 1113-1116